(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2001-356708 (P2001-356708A)

= mm (*/db.dc)

(43) 公開日 平成13年12月26日(2001, 12, 26)

(51) Int.Cl.		政別記号	FI			テーマコート(参考)	
G09F	9/30	3 3 0	G09F	9/30	3302	2 H O 9 2	
G02F	1/1345		G02F	1/1345		5 C O 2 7	
G09F	9/00	338	G09F	9/00	338	5 C 0 4 0	
H01J	9/02		H01J	9/02	F	5 C 0 9 4	
1	11/02			11/02	E	5G435	
			农简查審	未請求	請求項の数10	OL (全 14 頁)	
(21)出願番号		特願2000-178872(P2000-178872)	(71) 出顧人	(71) 出願人 599132708			
				富士通	日立プラズマディ	スプレイ株式会社	
(22)出願日		平成12年6月14日(2000.6.14)		神奈川県川崎市高津区坂戸3丁目2番1号			
			(72)発明者	小川	哲也		
				神奈川県	神奈川県川崎市高津区坂戸3丁目2番1号 富士通日立プラズマディスプレイ株式会		
				富士i			

(74)代理人 100065248

弁理士 野河 信太郎

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 表示パネルの電極橋造及びその電極形成方法

(57)【要約】

【課題】 表示パネルの電極構造及びその電極形成方法 に関し、基板端部のプロック境界部分にエッチング液の 流入を制限するダミー電極を設けることにより、表示領 域のプロック境界部分に位置する電極の過度のエッチン グを防止して、電極の幅が均一に仕上がるようにする。 【解決手段】 表示パネルを構成する基板上に、基板の 中央部に略平行に配置された表示電極部とその表示電極 部からプロック毎に所定本数ずつが収束されて基板端部 の端子部に至る斜行形状の引き出し電極部とからなる多 数本の電極を形成するとともに、プロックの境界部分で 異なる方向に斜行するとよの引き出し電極部の間に、電 極形成時のエッチングの際にプロックの境界部分へのエ ッチング液の流入を制限するためのダミー電極を設けた 構成とする。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 表示パネルを構成する基板上に、基板の中央部に略平行に配置された表示電極部とその表示電極部からプロック毎に所定本数ずつが収束されて基板端部の場子部に至る斜行形状の引き出し電極部とからなる多数本の電極を形成するとともに、プロックの境界部分で異なる方向に斜行する2本の引き出し電極部の間に、電極形成時のエッチングの際にプロックの境界部分へのエッチング被の流入を制限するためのダミー電極を設けてなる表示パネルの電極構造。

1

【請求項2】 ダミー電極が、ブロックの境界部分で異なる方向に斜行する2本の引き出し電極部に沿って形成されたほぼV字状の電極である請求項1記載の表示パネルの電極構造。

【請求項3】 ダミー電極が、電極の太さよりも太い請求項1又は2記載の表示パネルの電極構造。

【請求項4】 ダミー電極が、エッチング液の流入方向 に並置された複数の電極からなる請求項1~3のいずれ か1つに記載の表示パネルの電極構造。

【請求項5】 同じ基板上に、ダミー電極と引き出し電 20 極部とを連結する連結部がさらに形成されてなる請求項 1記載の表示パネルの電極構造。

【請求項 6】 基板上に電極材料層を形成し、その上に、基板の中央部に略平付に配置される表示電極部とその表示電極部からブロック毎上所定本数ずつが収束されて基板端部の端子部に至る斜行形状の引き出し電極部とからなる多数本の表示電極を形成するためのレジストパターンを形成し、それと同時に、ブロックの境界部分で身なる方向に斜行する2本の引き出し電極部を形成するためのレジストパターンの間に、ブロックの境界部分へ30のエッチング核の流入を制限するためのレジストパターンを形成した後、エッチングを行って電極を形成することからなる表示パネルの電極形成方法。

【請来項7】 エッチング液の流入制限用のレジストパターンが、ブロックの境界部分で異なる方向に斜行する 2本の引き出し電極を形成するためのレジストパターン に沿って形成されたほぼソ辛状のレジストパターンであ る請求項6記載の表示パネルの電極形成方法。

【請求項8】 エッチング液の流入制限用のレジストパ ターンが、電極形成用のレジストパターンの太さよりも 40 太いパターンである請求項6又は7記載の表示パネルの 電極形成方法。

【請求項9】 エッチング被の流入制限用のレジストパ ターンが、エッチング被の流入方向に並置された複数の レジストパターンからなる請求項6~8のいずれか1つ に記載の表示パネルの電極形成方法。

【請求項10】 基板上に等ピッチの電極部と部分的に 不等ピッチの電極端子部を有する複数の表示電極を備え た表示パネルの製造方法において、

前記基板上に電極材料層を形成した後、該電極材料層上 50

に形成すべき表示電極パターンに対応したレジスト膜を 形成するとともに、前記端干部の電極ビッチが広く形成 される領域にレジスト膜の流入を制限するパターンのレ ジスト膜を形成して、エッチングを行うことを特徴とす る表示パネルの製造方法。

2

【発明の詳細な説明】

[0001]

[発明が属する技術分野] 本発明は、表示パネルの電極 構造及びその電極形成方法に関し、さらに詳しくは、例 10 えばプラズマディスプレイパネル (PDP) や、液晶デ ィスプレイパネル、エレクトロルミネセンスディスプレ イのように基板上にエッチングで電極を形成する表示パ ネルの電極構造及びその電極形成方法に関する。

[0002]

【従来の技術】一般に、この種の表示パネルでは、電極 の形成はエッチングで行う場合が多い。このように基板 上にエッチングで電極を形成する場合、基板の全面に I T つやち n Os あるいはC r やC u、A g などの確極材 料層を素着法やスパッタ法、スロットコータ等の印刷法 で一様に形成し、その上にフォトリン法などで電極形状 のレジストパターンを形成し、その上からエッチング被 をシャワー状に注いで電極材料層をエッチングする、い わゆるスプレー式エッチングで電極を形成するようにし ている。

[0003]特に、近年では、上記のような表示パネルの製造装置は、量産化に応じて、コンペアラインでパネル基板を搬送しながら連続的に処理を行う、いわゆるコンペア形式のインライン型処理装置が主流を占めるようになってきている。このため、スプレー式エッチング

も、コンベアラインで基板を搬送しながら、定位置に配置したスプレー装置で順次基板にエッチング液を注ぐことにより行うようにしている。

【0004】ところで、上記のような表示パネルでは、例えば、図12に示すような形状の電極が基板上に形成される。図12は3電極面放電型PDPの前面側のガラス基板に形成される電極の例を示している。このPDPでは、電極は、基板11の中央部(表示領域)に、表示用の主放電(面放電)を発生させるためのペアとなる電極X、Yが水平方向に多数配置され、これらの電極X、Yが、複数のブロックに分割され、基板11の端部(表

となっている。
【0005】この例では、電極×が基板11の一方側 図示の例では左側)に収束され、電極×が基板11の 他方側(図示の例では右側)に収束されている。そし て、一方側の基板端部の端子部33と他方側の基板端部 の端子部33とで、異方導電性接着剤などによりフレキ シブルケーブル34にそれぞれ接続されて、各ドライバ

示領域外) でブロック毎にまとめられて収束された形状

【0006】図12では説明を簡単にするために、表示

に接続されるようになっている。

ライン (一対の電極 X. Yで表示されるライン) の8ラ インが1つのブロック(またはグループ)とされ、各ブ ロックの電極Xと電極Yが、それぞれ一方側と他方側の 端子部33に収束されているように図示したが、実際の 表示パネルでは、例えば、表示ラインの本数が480本 の表示パネルでは、ドライバの件能にもよるが、例えば 表示ラインは120本ずつの4つのブロックに分けら れ、各ブロックの120本の雷極Xと120本の電極Y が、それぞれ一方側と他方側の端子部33に収束され、 それぞれ4箇所の端子部33でフレキシブルケーブル3 10 4に接続される。

3

【0007】そして、上記のような表示パネルでは、大 型化や高精細化が進むにつれて、電極線幅が細くなり、 エッチング終了後の電極の形状や寸法は、精度や均一性 において、より高品質なものが要求されるようになって きている。

[0008]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、インラ イン型処理装置で基板を搬送しながらスプレー式エッチ ング法で電極材料層のエッチングを行うと、電極材料層 20 上に形成されたレジストパターンのブロック境界部分B に過剰のエッチング液が供給され、この部分で電極材料 層のエッチングが過度に行われるという問題がある。こ の点を以下に説明する。

【0009】図13は上述の電極X、Yが形成された基 板の基板端部の詳細を示す説明図である。以後、便宜 上、上述の電極X、Yの内、基板の表示領域において略 平行に配置された直線状の電極の部分を放電電極部51 と呼び、その放電電極部51からブロック毎に所定本数 ずつが収束されて基板端部の端子部33に至る斜行状の30 電極の部分を引き出し電極部52と呼ぶ。

【0010】この図に示すように、基板端部では、一方 の電極(例えばY電極)の放電電極部51だけが引き出 し雷極部52によって進出され端子部33に至る。その ため、当該Y電極については端子部33の電極間隔の方 が表示領域の電極間隔よりも狭い。またブロック境界部 分Bでは、当該Y電極の引き出し電極部52がブロック 境界部を挟んで互いに反対方向、つまり互いに離れる方 向に斜行するため、端子部の電極間隔は表示領域の電極 間隔よりも広い。さらに対をなすX、Y電極の放電スリ ット(放電部)となる電極間隙では端子部の電極間隔よ りも狭く、X、Y電極間の逆スリット(非放電部)とな る電極間隙では端子部の電極間隔よりも広い。つまり、 電極間隔は、基板中央部では大差ないが、基板端部では ブロック境界部で大きくなっており、この基板端部の電 極間隔の粗と密の関係がエッチングの際に問題となる。 【0011】図14は上述の電極形成用のレジストパタ ーンが形成された基板の基板端部の詳細を示す説明図で ある。この図に示すように、電極のレジストパターン、 つまり放電電極部形成用のレジストパターン51aと.

引き出し電極部形成用のレジストパターン52aと、端 子部形成用のレジストパターン33aとを形成して、基 板11を矢印Kの方向に搬送しながらスプレー式エッチ ングを行うと、エッチング液に矢印Fで示す相対方向の 流れが生ずる。これは以下の理由による。

【0012】図15は図14のA-A' 断面を示す説明 図である。すなわち、一般に、レジストパターン51 a. 52a. 33aは疎水性でエッチング液36を弾く 性質がある。このため、エッチング液36はレジストパ ターン51a、52a、33aの上には乗りにくく、電 極材料層31上に盛り上がった状態となる。したがっ て、エッチング液36はレジストパターン51a、52 a、33a上を乗り越えることなく、矢印Fで示す方向 に流れることになる。

【0013】この時、図14に示すように、ブロック境 界部分Bに着目すると、基板端部では、ブロック境界部 に位置しない端子質極相互の間隔よりも端子電極の間隔 が広く、エッチング液を受ける部分が広いため、流入す るエッチング液の量は多くなるが、表示領域では他の電 極形成用のレジストパターンの間隔と同じになる。した がって、 基板端部のエッチング液が下方向に流れ、 引き 出し電極部形成用のレジストパターン52aに沿って集 中されて表示領域に流入すると、表示領域ではエッチン グ液の流入量が多くなり、流速が速くなる。

【0014】このため、図15に示すように、ブロック 境界部分Bに位置する電極材料層32のエッチング速度 が、ブロック境界部分Bに位置しない部分と比較して早 まり、その結果、ブロック境界部分Bに位置する電板 (図14に斜線で示す)の放電電極部51は、ブロック

境界部分Bに位置しない電極の放電電極部51よりも過 度にエッチングされ、細い幅に仕上がる。

【0015】図16はエッチング後の電極の形状を示す 図15対応図である。この図で示すように、ブロック境 界部分Bに位置する雷極の放電雷極部51 (図中斜線で 示す)は、ブロック境界部分Bに位置しない電極の放電 電極部51よりも細く形成される。そのため、完成後の 表示パネルに電極方向の表示ムラが生じる原因の一つと

【0016】さらに、図13に示すように、基板端部で は、収束される側の電極(図の場合はY電極)はブロッ ク境界部分Bで各プロックの電極が互いに離れる方向に 斜行するため、そのブロック境界部において隣接する電 極の間隔が他の部分の電極間隔よりも広くなり、電極間 隔の広い電極間の結合容量が電極間隔の狭い電極間のそ れとは異なるようになるため、電気的特性にも不均一が

【0017】本発明は、このような事情を考慮してなさ れたもので、基板端部のブロック境界部分にエッチング 液の流入を制限するダミー電極を設けることにより、表 50 示領域のブロック境界部分に位置する電極材料層の過度

のエッチングを防止し、さらに、製造後は、そのダミー 雷極を結合容量の不均一の補正に利用することで、端子 間隔の不連続に伴う電気的特性の不均一を是正するよう にした表示パネルの電極構造及びその電極形成方法を提 供するものである。

[0018]

【課題を解決するための手段】本発明は、表示パネルを 構成する基板上に、基板の中央部に略平行に配置された 表示電極部とその表示電極部からブロック毎に所定本数 ずつが収束されて基板端部の端子部に至る斜行形状の引 10 き出し電極部とからなる多数本の電極を形成するととも に、ブロックの境界部分で異なる方向に斜行する2本の 引き出し質極部の間に、電極形成時のエッチングの際に プロックの境界部分へのエッチング液の流入を制限する ためのダミー電極を設けてなる表示パネルの電極構造で ある。

[0019]

【発明の実施の形態】本発明において、表示パネルを構 成する基板としては、ガラス、石英、シリコン、セラミ ック等の基板や、これらの基板上に、電極、絶縁膜、誘 20 電体層、保護膜等の所望の構成物を形成した基板が含ま れる。

【0020】電極は、表示電極部と引き出し電極部とで 構成されていればよい。この質極は、特に限定されず、 当該分野で公知の電極材料及び形成方法をいずれも使用 して形成することができる。電極材料としては、例え ば、ITO、SnO2、Ag、Au、Al、Cu、Cr 及びそれらからなる合金や積層体(例えばCェノCェノ Crの積層構造) 等が挙げられる。電極の形成方法とし ては、例えば基板に電極材料層を蒸着法、スパッタ法等 30 の成膜法で一様に形成し、その上にフォトリソ法などで 電極形状のレジストパターンを形成し、その上からスプ レー式エッチングを施すことで形成することができる。 いったん形成した電極上に異なるパターンの電極を形成 する場合は、同様の工程を繰り返すことにより形成する ことができる。このような形成方法により、所望の本 数、厚さ、幅及び間隔で電極を形成することができる。

【0021】ダミー電極は、ブロックの境界部分で異な る方向に収束される2本の引き出し電極部の間に形成さ れていればよい。このダミー雷極は、電極形成時のエッ 40 チングの際に、ブロック境界部分へのエッチング液の流 入を制限するために設けられる。ダミー電極は、工程の 簡略化のためには、電極の形成時に、電極と同じ材料及 び形成方法で形成することが望ましい。

【0022】上記の構成において、ダミー電極は、ブロ ックの境界部分で異なる方向に斜行する2本の引き出し 電極部に沿って形成されたほぼV字状の電極であること が望ましい。

【0023】また、ダミー電極は、電極の太さよりも太

6 液の流入方向に並置された複数の電極で構成してもよ く、この場合、複数のダミー雷極は、それぞれ異なる太 さを有していてもよい。

【0024】また、電極間の結合容量を均一化するため には、同じ基板上に、図11に示すように、ダミー電極 と一方の引き出1.質極部とを連結する連結部8をさらに 形成することが望ましい。これにより、図中のG部とI 部の結合容量を同じにできる。

【0025】本発明は、また、基板上に電極材料層を形 成し、その上に、基板の中央部に略平行に配置される表 示電極部とその表示電極部からブロック毎に所定本数ず つが収束されて基板端部の端子部に至る斜行形状の引き 出し電極部とからなる多数本の表示電極を形成するため のレジストパターンを形成し、それと同時に、ブロック の境界部分で異なる方向に斜行する2本の引き出し電極 部を形成するためのレジストパターンの間に、 ブロック の境界部分へのエッチング液の流入を制限するためのレ ジストパターンを形成した後、エッチングを行って電極 を形成することからなる表示パネルの電極形成方法であ

【0026】本電極形成方法において、エッチング液の 流入制限用のレジストパターンは、ブロックの境界部分 で異なる方向に斜行する2本の引き出し電極を形成する ためのレジストパターンに沿って形成されたほぼV字状 のレジストパターンであることが望ましい。

【0027】また、エッチング液の流入制限用のレジス トパターンは、電極形成用のレジストパターンの太さよ りも太いパターンであることが望ましい。さらに、エッ チング液の流入制限用のレジストパターンは、エッチン グ液の流入方向に並置された複数のレジストパターンで 構成してもよく、この場合、複数のエッチング液の流入 制限用のレジストパターンは、それぞれ異なる太さを有 していてもよい。

【0028】以下、本発明の実施の形態を実施例に基づ き図面を参照して説明する。なお、これによって本発明 が限定されるものではない。

【0029】まず、本発明の雷極構造を有する表示パネ ルの構成を、図1に示すPDPを例にとり説明する。図 1は一般的なAC型3電極面放電形式のPDPを部分的 に示す斜視図である。なお、図1の構成は一例であり、 本発明はこれに限定されることなく、パネル基板上にエ ッチングで電極を形成する表示パネルであれば、どのよ うな表示パネルであっても適用することができる。 【0030】 PDP10は、前面側のパネルアセンブリ と背面側のパネルアセンブリから構成されている。

【0031】前面側のパネルアセンブリは、一般的に、 前面側の基板11上に表示のラインL毎に一対のストラ イプ状の表示(サスティン)電極X,Yが横方向に平行 に形成され、表示電極X. Yを覆うように誘電体層17 いことが望ましい。さらに、ダミー電極は、エッチング 50 が形成され、誘電体層17上に保護膜18が形成された 構成となっている。

7 【0032】前面側の基板11は、通常はガラス基板で 形成されるが、石英ガラス基板等で形成してもよい。

【0033】表示電極X, Yは、後述する本発明の表示 パネルの質極構造を有しており、さらに本発明の電極形 成方法によって形成される。

【0034】誘電体層17は、PDPに通常使用されて いる材料で形成される。具体的には、例えば低融点ガラ ス粉末とバインダーとからなるペーストを基板上にスク リーン印刷法などで涂布し、焼成することにより形成す 10 ることができる。

【0035】保護膜18は、表示の際の放電により生じ るイオンの衝突による損傷から誘電体層17を保護する ために設けられる。保護膜18は、例えば、MgO、C aO、SrO、BaO等からなる。

【0036】背面側のパネルアセンブリは、一般的に、 背面側の基板21上に複数本のストライプ状のアドレス (データ) 電極Aが縦方向に平行に形成され、アドレス 電極Aを覆うように懸電体層24が形成され、懸電体層 2.4 上に放電空間を仕切るための複数のストライプ状の 20 隔壁29がアドレス電極A間に平行に形成され、隔壁2 9間の溝内の底面と側面にストライプ状の蛍光体層28 R、28G、28Bが形成された構成となっている。

【0037】背面側の基板21は前面側の基板11と同 じ種類のものを使用することができる。また、誘電体層 24は、前面側の基板11上の誘電体層17と同じ種類 のものを使用することができる。

【0038】アドレス電極Aも表示電極X、Yと同様 に、本発明の表示パネルの電極構造を有しており、さら に本発明の電極形成方法によって形成される。

【0039】隔壁29は、サンドブラスト法、印刷法、 フォトエッチング法等により形成することができる。例 えば、低融点ガラス粉末とバインダーとからなるペース トを誘電体層24上に塗布して焼成した後、サンドブラ スト法で切削することにより形成することができる。ま た、バインダーに感光性の樹脂を使用し、マスクを用い た露光及び現像の後、焼成することにより形成すること も可能である。

【0040】蛍光体層28R、28G、28Bは、蛍光 体粉末とバインダーとを含む蛍光体ペーストを隔壁29 間の溝内にスクリーン印刷やディスペンサを用いた方法 等で塗布し、これを各色毎に繰り返した後、焼成するこ とにより形成することができる。また、この蛍光体層2 8R, 28G, 28Bは、蛍光体粉末とバインダーとを 含むシート状の蛍光体層材料(いわゆるグリーンシー ト)を使用し、フォトリソ法で形成することもできる。 この場合、所望の色のシートを基板上の表示領域全面に 貼り付けて、露光、現像を行い、これを各色毎に繰り返 すことで、対応する隔壁間に各色の蛍光体層を形成する ことができる。

【0041】PDP10は、上記した前面側のパネルア センブリと背面側のパネルアセンブリとを、表示電極 X、Yとアドレス電極Aとが直交するように対向配置 し、周囲を封止し、隔壁29で囲まれた空間にネオン、 キセノンなどの放電ガスを充填することにより作製され る。このPDP10では、一対の表示電極X、Yとアド レス電極Aとの交差部の放電空間が表示の最小単位であ る1つのセル領域(単位発光領域)となる。

【0042】前述したように、表示電極X、Y、及びア ドレス電極 A は 本発明の表示パネルの常極構造を有1. ており、さらに本発明の雷極形成方法によって形成され る。以下、この点について説明する。

【0043】図12に示したように、表示電極X.Y は、基板11の中央部(表示領域)に、表示用の主放電 (面放電)を発生させるためのペアとなる表示電板 X. Yが水平方向に多数配置され、これらの表示電極X,Y が、複数のブロックに分割され、基板11の端部(表示 領域外)でブロック毎にまとめられて収束された形状と なっている。そして、互いに反対側の基板端部に導出さ れた端子部で、異方導雷性接着剤などによりフレキシブ ルケーブルに接続されて、各ドライバに接続されてい

【0044】具体的には、本PDP10は、表示ライン の本数が480本の表示パネルであり、表示ラインが1 20本ずつの4つのブロックに分けられ、各ブロックの 120本の表示電極Xと120本の表示電極Yが、それ ぞれ一方側と他方側の端子部に収束され、それぞれ4箇 所の端子部でフレキシブルケーブルに接続されている。 【0045】すなわち、表示電極X、Yは、基板の表示

領域において略平行に配置された直線状の放電電極部 (表示電極部) と、その放電電極部からブロック毎に所 定本数ずつが収束されて反対側の基板端部の端子部に至 る斜行状の引き出し電極部から構成されている。

【0046】この表示電極X、Yは、ITO、SnO などの透明電極12と、電極の抵抗を下げるための、例 えばAg、Au、Al、Cu、Cr及びそれらの積層体 (例えばCr/Cu/Crの積層構造) 等からなる金属 製のバス電極13から構成されている。

【0047】表示電極X、Yの形成はエッチングで行 う。すなわち、基板11の全面に、まず、ITO、Sn O。などの透明電極用の電極材料層を蒸着法、スパッタ 法等の成膜法で一様に形成し、その上にフォトリソ法な どで電極形状のレジストパターンを形成し、その上から スプレー式エッチングを施すことで透明電極12を形成 する。そして、次にバス電極13の電極材料を用いて同 様の工程を繰り返すことによりバス電極13を形成す る。なお、バス電極13は基板端部の端子部に至る長さ 寸法で形成されるが、透明電極12は引き出し電極部の 中途で止まる長さ寸法で形成される。つまり端子部はバ 50 ス電極のみで形成される。これにより、表示電極X, Y を、所望の本数、厚さ、幅及び間隔で形成する。

【0048】PDP10の製造は、インライン型処理装置を用いて行う。したがって、炭示電棒X、Yのエッチングは、スプレー式エッチングは、コンペアラインで基板11を搬送しながら、定位置に配置したスプレー装置(図示しない)で順次基板11にエッチング液を注ぐことによりだった。

【0049】アドレス電極Aは、例えばAg、Au、A1、Cu、Cr及びそれらの積層体(例えばCr/Cu 10/Crの積層構造)等から構成される。アドレス電極Aも表示電極X、Yと同様に、蒸着法、スパッタ法等の成膜法、並びにフォトリソ法とスプレー式エッチング法を組み合わせることにより、所望の本数、厚さ、幅及び間隔で形成する。なお、アドレス電極の端子部は、1本おきに互いに反対側の基板端部に導出してもよいし、同じ側の基板端部に導出してもよいが、通常前者を採用している。

【0050】このような表示電極X, Y、及びアドレス 電極Aの詳細な電極構造と、スプレー式エッチングによ 20 る電極形成方法を、以下に説明する。

【0051】図2は本発明の表示パネルの電極構造及び その電極形成方法の一実施例を示す説明図である。この 図は、表示電極X、Yにおけるパス電極形成用のレジス トパターンが形成された基板の基板端部の詳細を示す説 明図であり、従来の構成で示した図14対応図である。 なお、透明電極については図を省略している。

【0052】図2において、Bはプロック境界部分、5 1 a., 51 a.はX電極、Y電極の放電電極部形成用の レジストパターン、52 a., 52 a.はY電極の引き出 30 し電極部形成用のレジストパターン、3 3 a., 33 a. はY電極の端子部形成用のレジストパターン、5 a はダ ミー電極形成用のレジストパターン(図中斜線で示す) である。ダミー電極形成用のレジストパターン5 a は、 端子部用のレジストパターン33 a., 33 a.を含み、 この端子部の位置までダミー電極を形成する。

[0053] 一のブロックの引き出し電極部形成用のレジストパターン52a」と、他のブロックの引き出し電極部形成用のレジストパターン52a」とは、ブロック境邦部分Bから2方向に互いに振り分けられて、異なる 40端子部形成用のレジストパターン33a1,33a1へ向けて配置されている。

【0054】この図に示すように、本例では、電極材料 層上にレジストパターンを形成する際に、ブロック境界 部分Bに流入するエッチング液を制限するために、PD Pの画像表示動作に直接関係しないぞミー電極形成用の レジストパターン5 aを形成する。

【0055】このダミー電極形成用のレジストパターン 5aは、ブロック境界部分Bに位置し、引き出し電極部 形成用のレジストパターン52a,と、引き出し電極部 形成用のレジストパターン52 a: とにそれぞれ平行に 配置された略"V"字状のパターンであり、隣接する電 極のレジストパターンとほぼ同様のパターン幅、パター ン間隔で形成する。

[0056] このダミー電極形成用のレジストパターン 5aを形成することにより、図3に示すように、基板1 1を矢印Kの方向に搬送しながらスプレー式エッチング を行っても、プロック境界部分Bへのエッチング液の過 刺な供給が阻止される(図中矢印Eで示す)ので、エッ チング液の流れ(図中矢印Fで示す)は、ブロック境界 部分Bで備基が多くならず、全体に一様となる。

【0057】図4は図3の8-B′断面を示す説明図であり、上述のようにエッチング液の流れが全体に一様になることにより、ブロック焼界部分Bに位置する電極材料層32のエッチング速度が他の部分とほぼ同じになり、ブロック焼界部分Bに位置する電極材料層32の通のエッチングが防止される。その結果、ブロック焼界部分Bに位置しない電極の放電電極部53の幅は、ブロック境界部分Bに位置しない電極の放電電極部51とほぼ同じ編に付上があ。

【0058】図5はエッチング後の電極の形状を示す図 4対応図である。この図で示すように、ブロック境界部 分Bに位置するX、Y電極の放電電極部53(図中斜線 で示す)は、ブロック境界部分Bに位置しないX、Y電 極の放電電極部51とほぼ同じ太さに形成される。

【0059】このように、電極形成時に、ダミー電極形成用のレジストパターン5aを形成することにより、ブロック境界部分Bに位置する電極材料層の過度のエッチングを防止して、均一な寸法の電極を形成することができ、完成後の表示パネルに電極方向の表示ムラが生じることを防止することができる。

【0060】上記では、ダミー電極形成用のレジストバターン5 a は、隣接する電極のレジストバターンとほぼ 同様のパターン幅で振すると述べたが、このパターン幅は、他の電極のレジストパターンよりも太く形成してもよい。この場合、ダミー電極形成用のレジストパターン5 a 上をエッチング液が、より乗り聴えにくくなる。【0061】図6はダミー電極形成用のレジストパターンの第1の変形例を示す説明図である。本例では、効果を高端のために、他の電極のレジストパターンよりも広い幅のグミー電極形成用のレジストパターン6 a を形成している。このようにダミー電極形成用のレジストパターン6 a の幅を広くすることで、エッチング液の流れをより歩ーにすることができる。

【0062】図7はダミー電極形成用のレジストパター ンの第2の変形例を示す説明図である。本例では、より 効果を高めるために、ダミー電極形成用のレジストパタ ーンをエッチング液の流れる方向に2本並置している。 すなわち、ダミー電極形成用のレジストパターン5。 ダミー電極形成用のレジストパターン5。と 50 ダミー電極形成用のレジストパターン7。との2本で構 成している。これらのダミー電極形成用のレジストパタ 一ン5 a , 7 a は、他の電極のレジストパターンと同じ 電形成している。このように、ダミー電極形成用のレ ジストパターンの本数を増加することにより、エッチン グ液の流れをより均一にすることができる。

[0063] なお、上記では、ダミー電極形成用のレジストパターンを2本形成しているが、必要に応じて3本以上に増加してもよい。また、ダミー電極形成用のレジストパターンの太さも必要に応じて適切な太さに調整してよい。

【0064】図8はダミー電極形成用のレジストパターンの幅を変化させた第3の変形例を示す説明図である。本例では、ダミー電極形成用のレジストパターンを、他の電極のレジストパターンと同し幅のレジストパターンで、他の電極のレジストパターンと同し幅のレジストパターンで、風ではエッチング液の流れる方向(図3の矢印下方向)に対して下流側に広い幅のレジストパターンと記している。ない。また、必要に応じて3な、これに限定されることなく、上流側に広い幅のレジストパターンを配置してもよい。また、必要に応じて3な以上を配置したり、太さを変更したり、太いレジストパターンと細いレジストパターンの組み合わせを任意に変更したりしてもよい。

【0065】このように、ダミー電極形成用のレジストパターンを、他の電極のレジストパターンよりも広い幅のレジストパターンと同じ幅のレジストパターンと同じ幅のレジストパターンと同じ幅のレジストパターンと同じ幅のレジストパターンよりも広い幅のレジストパターン6aだけを2本設けた場合と、他の電極のレジストパターンと同じ幅のレジストパターン7aだけを2本設けた場合との、ほぼ中間の効果を得ることができる。

[0066] 図りはダミー電極と引き出し電極額とを連結する連結部形成用のレジストパターンを設けた例を示 対説明図である。本例では、ダミー電極形成用のレジストパターン5aを設けるとともに、連結部形成用のレジストパターン5aを設けるとともに、連結部形成用のレジストパターン8aを設け、これにより引き出し電極郷とダミー電板と幸遠結する。

[0067] 終行状の引き出し電極部を設けた場合、電 極の結合容量値がプロック境界部分Bで変化する。すな 40 わち、図10に示すように、放電電極部51では、全て の電極が平行であるため、隣接する電極との間に生ずる 結合容量は、全ての電極でほぼ同じである。しかし、引 き出し電極部52では、隣接する電極との間に生ずる結 合容量は、プロック境界部分Bに位置する電極とそうで ない電板とで異なる。

【0068】具体的には、引き出し電極部52uiに着 目した場合、引き出し電極部52uiとその上部に位置 する引き出し電極部52uiとの間に生ずる結合容量G と、引き出し電極部52uiとその下部に位置する引き 出し電極部52d,との間に生ずる結合容量日とは、その値が異なる。したがって、この結合容量の異なりが、 ブロック境界部分Bにおける表示ムラの原因の一つと考 まられる。

12

【0069】これを解決するために、図11に示すように、連結部8を設けて、ダミー電極5と引き出し電極節52点とを連結する。このように連結すれば、引き出し電極部52点に発育した場合、引き出し電極部52点にとの同に生する場合容量と、引き出し電極部52点との同に生する結合容量1とが、ほぼ同じ値となる。また、引き出し電極部52点に発情が52点に着目とよる、引き出し電極部52点にといるではでいる。といいの間に生する結合容量と、引き出し電極部52点にといいの間に生する結合容量と、引き出し電極部52点に必要がある。

【0070】このように、電極形成時に、ダミー電極形成用のレジストパターン5aとともに連結部形成用のレジストパターン8aを設けて、ダミー電極5と引き出し電極部52での結合容量が全ての電極でほぼ同一となるので、均一な電気特性を有する表示パネルとすることができる。

【0071】連結部8はダミー電極5の形成時には常に 形成しておくことが望ましい。複数のダミー電極を形成 する場合には、最も下流のダミー電極が引き出し電極部 52点に連結されるように、連結部形成用のレジスト バターン8ヵを形成する。

【0072】ダミー電優形成用のレジストパターン5aによって形成されたダミー電極5と、連結研形成用のレジストパターン8aによって形成された連結節8とは、他の電極と同様に完成したPDP上に残される。

【0073】これにより、PDPの製造時に、ブロック 境界部分へエッチング液が流入することを制限する効果 と、完成したPDPの駆動時に、結合容量を均一化して 表示ムラをなくす効果との両方の効果を得ることができ

【0074】上記では、連結部8で、ダミー電極5をダ ミー電極5よりも下側の引き出し電極部524、に連結 したが、ダミー電極5を上側の引き出し電極部524、 に連結してもよい。連結部8は、表示の妨げにならない 位置であればどこに形成してもよいが、エッチング液が 乗り越えにくいように、十分な幅を持たせることが望ま しい。

【0075】このようにして、ダミー電極形成用のレジストパターンを形成することにより、PDPの製造時における電極形状の均一化を図ることができる。すなわち、ブロック境界部分へのエッチング液の流入を制限して、ブロック境界部分に軟、電極間隙部に接する電極エ

13

ッジの過度のエッチングを防止し、これにより、均一な 寸法の電極を形成して、完成後の表示パネルに電極方向 の表示ムラが生じることを防止することができる。

[0076]また、電極開結合容量の均一化を図り、これにより電気的な特性の均一化を図ることができる。すなわち、連結部を形成して、ダミー電極と引き出し電極部とを連結することにより、引き出し電極部の結合容量を全ての電極でほぼ同一にして、均一な電気特性の表示パネルとすることができる。

[0077] なお、本祭明実施例及び図12(従来例)のように、両側に端子を取り出す場合は、基板の出口側にも、同様のダミー電極形成用のレジストバターンを設けることで、出口側付近での核の流速低下による電極の太りを防止することができる。また、結合容量の均一化を図るためにも、出口側にダミー電極を設けることが望ましい。

[0078]上記では、前面側の基板11上に表示電極 X、Yを形成する例を説明したが、背面側の基板21上 にアドレス電極Aを形成する場合も同様にして形成する ことができる。

[0079]

【発明の効果】本発明によれば、高精細の電極パターン を高精度でより均一に作製することができ、これにより フロック境界部分での表示ようを防止することができ る。また、ダミー電極と引き出し電極部とを連結する連 結節を設けた場合には、電極の結合容量が全ての電極で ほぼ同一になるので、均一な電気特性の表示パネルとす ることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】一般的なAC型3電極面放電形式のPDPを部 30分的に示す斜視図である。

【図2】本発明の表示バネルの電極構造及びその電極形成方法の一実施例を示す説明図である。

【図3】 実施例のエッチング液の流れを示す説明図である。

【図4】図3のB−B′断面を示す説明図である。

【図5】 実施例のエッチング後の電極の形状を示す図4 対応図である。

【図 6 】実施例におけるダミー電極形成用のレジストバ ターンの第 1 の変形例を示す説明図である。

【図7】実施例におけるダミー電極形成用のレジストバターンの第2の変形例を示す説明図である。

【図8】実施例におけるダミー電極形成用のレジストバ ターンの幅を変化させた第3の変形例を示す説明図であ る。

【図9】 実施例におけるダミー電極と引き出し電極部と を連結する連結部形成用のレジストパターンを設けた例 を示す説明図である。

(8)

【図10】引き出し電極部の結合容量値の異なりを示す 説明図である。

【図11】実施例において連結部を形成した状態を示す 説明図である。

【図12】従来のパネル基板に電極が形成されるタイプ の表示パネルの電極構造を示す説明図である。

【図13】従来の電極X、Yが形成された基板の基板端

部の詳細を示す説明図である。 10 【図14】従来の電極形成用のレジストパターンが形成

された基板の基板端部の詳細を示す説明図である。 【図15】図14のA-A′断面を示す説明図である。

【図16】従来のエッチング後の電極の形状を示す図1 5対応図である。

【符号の説明】

5 ダミー電極

5 a , 6 a , 7 a , 8 a ダミー電極形成用のレジスト パターン

10 PDP

11 前而側の基板

12 透明電極

13 バス電極

17 誘電体層

18 保護膜

21 背面側の基板

22 下地層 24 誘電体層

28R. 28G. 28B 蛍光体層

2.9 隔壁

31 電極材料層 32 ブロック境: 33 端子部

32 ブロック境界部分Bに位置する電極材料層

33a1、33a2 端子部形成用のレジストパターン

33as, 33a。 端子部用のレジストパターン

34 フレキシブルケーブル 51,53 放電電極部

5 1 a 1 . 5 1 a 2 放電電極部形成用のレジストパター

52,52 u.,52 u.,52 d.,52 d. 引き出し 40 電極部

52a1,52a2 引き出し電極部形成用のレジストパターン

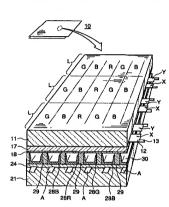
A アドレス電極

B ブロック境界部分

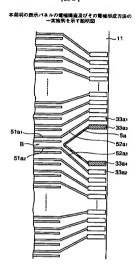
T. ライン

X. Y 表示雷極

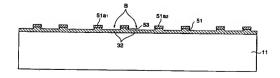
【図1】
一般的なAC型3環機面放電形式のPDPを紹介的に示す結構図

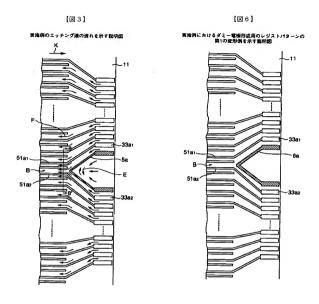


【図2】

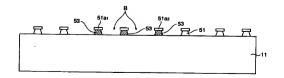


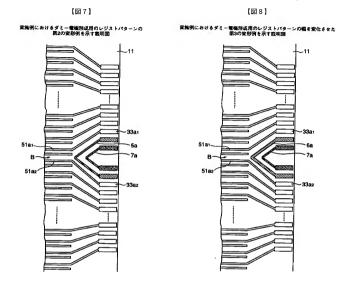
【図4】 図3の B-B 断面を示す説明図





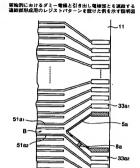
【図 5 】 実施例のエッチング後の電極の形状を示す図4対応図



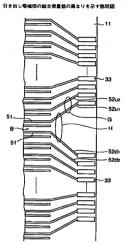


[図12]

[図9]

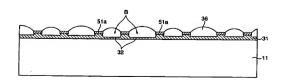


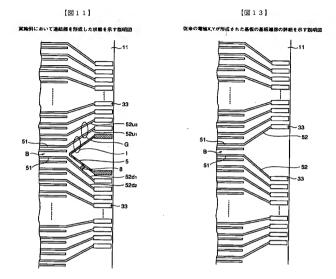
[図10]



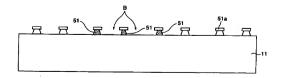
【図15】

図14の A-A' 断面を示す説明図



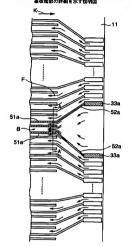


【図 1 6 】 従来のエッチング後の電極の形状を示す図15対応図



[図14]

従来の電極形成用のレジストパターンが形成された基板の 基板階部の詳細を示す説明図



フロントページの続き

Fターム(参考) 2H092 GA33 GA41 GA48 GA50 GA61

HA03 HA04 HA25 MA04 MA05

MA15 MA18 NA01

5C027 AA01

5C040 FA01 FA04 GA02 GA03 GC19

JA14 JA15 MA23

5C094 AA03 AA21 BA27 BA31 BA43

CA19 CA24 EA01 EA04 EA07

EB02 FB12 FB15 FB16

5G435 AA00 BB05 BB06 BB12 EE33

HH12 HH14 KK05